# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-297327

(43)Date of publication of application: 10.11.1995

(51)Int.Cl.

H01L 23/36

(21)Application number: 06-089497

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

27.04.1994

(72)Inventor: TAKEUCHI TSUYOSHI

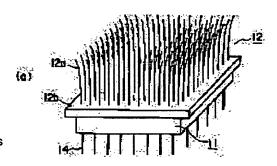
SHIMIZU SHINYA

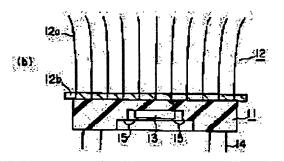
### (54) SEMICONDUCTOR DEVICE AND MANUFACTURE THEREOF

### (57)Abstract:

PURPOSE: To expect a sufficient heat dissipation effect and to cope flexibly with the change in the mounting space in a ceramic package provided with a heat sink.

CONSTITUTION: For example, a plurality of thin pure copper wires 12a of a heat sink 12 for heat dissipation of a PGA are fixed with a solder 12b each at one end. The other end of each wire is spread in the radiation pattern, so that the heat sink 12 is formed. The heat sink 12 is fixed to the surface of a ceramic case 11 of the PGA with the solder 12b.





### **EGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

# 特開平7-297327

(43)公開日 平成7年(1995)11月10日

(51) Int.Cl.6

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H01L 23/36

H01L 23/36

Z

審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 5 頁)

(21)出願番号

特願平6-89497

(71)出願人 000003078

株式会社東芝

(22)出顧日

平成6年(1994)4月27日

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

(72)発明者 武内 強

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株

式会社東芝多摩川工場内

(72)発明者 清水 真也

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株

式会社東芝多摩川工場内

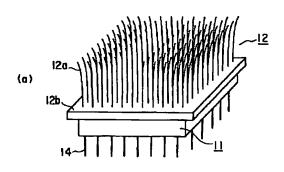
(74)代理人 弁理士 鈴江 武彦

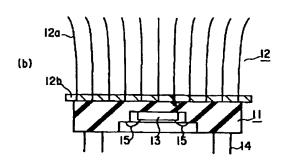
#### (54) [発明の名称] 半導体装置およびその製造方法

# (57)【要約】

【目的】本発明は、ヒートシンクが設けられてなるセラミックパッケージ装置において、十分な放熱効果が期待でき、実装スペースの変化にも柔軟に対応できるようにすることを最も主要な特徴とする。

【構成】たとえば、PGAの放熱のためのヒートシンク12を、複数本の細い純銅線12aの一端を半田12bにより固着させ、それぞれの他端を放射状に拡げて形成する。そして、このヒートシンク12を、PGAのセラミックケース11の表面に上記半田12bにより固着させてなる構成とされている。





#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 半導体チップを収納する外囲器の表面上 に、放熱性の優れた金属細線の集合体よりなる放熱体を 設けたことを特徴とする半導体装置。

【請求項2】 半導体チップを収納する外囲器の表面上 に、複数の、放熱性の優れた金属細線の一端を束ねて固 着し、他端を放射状に配置してなる放熱体を設けたこと を特徴とする半導体装置。

【請求項3】 半導体チップを収納する外囲器の表面上 に、放熱性の優れた金属細線を金属タワシ状に形成して 10 目的としている。 なる放熱体を設けたことを特徴とする半導体装置。

【請求項4】 半導体チップを収納する外囲器の表面上 に 放熱性の優れた金属細線の集合体よりなる放熱体を 固着剤により固着するようにしたことを特徴とする半導 体装置の製造方法。

【請求項5】 半導体チップを収納する外囲器の表面上 に、複数の、放熱性の優れた金属細線の一端を束ねて固 着剤により固着し、その金属細線の他端を所定の長さに 揃えて切断した後、放射状に配置して放熱体を形成する ようにしたことを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項6】 半導体チップを収納する外囲器の表面上 に、放熱性の優れた金属細線を金属タワシ状に形成して なる放熱体を固着剤により固着するようにしたことを特 徴とする半導体装置の製造方法。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】との発明は、たとえば放熱体を設 けてなる半導体装置およびその製造方法に関するもの で、特にセラミックパッケージ装置などに用いられるも のである。

## [0002]

【従来の技術】従来、発熱が問題となる、たとえばセラ ミックパッケージ装置の場合、図3に示すように、パッ ケージ1上にヒートシンク2を設けることで、発熱の問 題を解決している。

【0003】セラミックパッケージ装置に用いられるヒ ートシンクとしては、図に示したような、機械的加工に より形成された下駄歯形状のもののほか、円板形状のも のが一般的となっている。また、多数の円柱形状体を林 立してなるヒートシンクも考案されている。

【0004】しかしながら、ヒートシンクは、その表面 **積が放熱効果に影響するため、ある程度の放熱効果を得** ようとする場合には大型化が避けられないという問題が あった。

【0005】また、十分な放熱効果を得ようとする場合 にはヒートシンクの表面積をかせぐ必要がある反面、セ ラミックパッケージの実装スペースによってはヒートシ ンクの表面積を必要以上にかせぐことができず、したが って十分な放熱効果を得るのがむずかしという問題があ った。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】上記したように、従来 においては、ある程度の放熱効果を得ようとする場合に はヒートシンクの大型化が避けられない反面、実装スペ ースによってはヒートシンクの表面積を十分にかせぐこ とができないなどの問題があった。

【0007】そとで、との発明は、十分な放熱効果が期 待でき、実装スペースの変化にも柔軟に対応することが 可能な半導体装置およびその製造方法を提供することを

#### [0008]

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた めに、この発明の半導体装置にあっては、半導体チップ を収納する外囲器の表面上に、放熱性の優れた金属細線 の集合体よりなる放熱体を設けた構成とされている。

【0009】また、との発明の半導体装置にあっては、 半導体チップを収納する外囲器の表面上に、複数の、放 熱性の優れた金属細線の一端を束ねて固着し、他端を放 射状に配置してなる放熱体を設けた構成とされている。

【0010】さらに、この発明の半導体装置にあって 20 は、半導体チップを収納する外囲器の表面上に、放熱性 の優れた金属細線を金属タワシ状に形成してなる放熱体 を設けた構成とされている。

【0011】同じく、この発明の半導体装置の製造方法 にあっては、半導体チップを収納する外囲器の表面上 に、放熱性の優れた金属細線の集合体よりなる放熱体を 固着剤により固着するようになっている。

【0012】また、この発明の半導体装置の製造方法に あっては、半導体チップを収納する外囲器の表面上に、 30 複数の、放熱性の優れた金属細線の一端を束ねて固着剤 により固着し、その金属細線の他端を所定の長さに揃え て切断した後、放射状に配置して放熱体を形成するよう になっている。

【0013】さらに、この発明の半導体装置の製造方法 にあっては、半導体チップを収納する外囲器の表面上 に、放熱性の優れた金属細線を金属タワシ状に形成して なる放熱体を固着剤により固着するようになっている。 [0014]

【作用】この発明は、上記した手段により、同一体積あ 40 たりの表面積を増加できるようになるため、その分だけ 放熱効果またはコンパクト性を向上することが可能とな るものである。また、上記した手段により、柔軟性をも って形成できるようになるため、容易に変形させること が可能となるものである。

#### [0015]

【実施例】以下、との発明の実施例について図面を参照 して説明する。図1は、第1の実施例にかかるセラミッ クバッケージ装置の概略構成を示すものである。なお、 同図(a)はセラミックパッケージ装置の概略構成を示 50 す外観斜視図であり、同図(b)は同じく断面図であ

る。

【0016】すなわち、このセラミックバッケージ装置は、たとえばPGA(Pin Grid Array)のパッケージ(外囲器)を形成するセラミックケース11の表面に、放熱体としてのヒートシンク12が設けられた構成とされている。

[0017] PGAは、たとえば上記セラミックケース 11内に半導体チップ13を収納してなり、その裏面より、多数のリード端子14が並んで突き出した構成とされている。

【0018】PGAの、各リード端子14は、半導体チップ13上の電極パッド(図示していない)のそれぞれと、ボンディングワイヤ15を介して電気的に接続されている。

【0019】ヒートシンク12は、たとえば複数本の細い純銅線(金属細線)12aの一端を固着剤としての半田12bによりまとめ、それぞれの他端を放射状に拡げてなる構成とされている。

【0020】とのヒートシンク12は、たとえば上記半田12bにより、PGAのセラミックケース11の表面 20に固着されるようになっている。とこで、ヒートシンク12の形成方法について説明する。

【0021】たとえば、複数本の純銅線12aの一端が、東ねられるようにして半田12bに固着される。そして、それぞれの純銅線12aが所定の長さに揃えられて切断された後、各純銅線12aの他端が放射状に拡げられる。

[0022] とのようにして形成されるヒートシンク12は、半田12bにより固着させる純銅線12aの本数を増やし、できるだけ密に固着させることにより、その 30表面積をかせぐことが可能となる。

【0023】すなわち、このヒートシンク12の場合、 純銅線12aの本数を増やすことにより、同一体積あた りの表面積を容易に増加することができる。これによ り、従来の下駄歯構造のヒートシンクなどに比して、簡 単に、かつ格段に、その表面積を増大させることが可能 となる。したがって、熱抵抗を低下できるとともに、よ り高い放熱効果が得られるようになるものである。

【0024】しかも、半田12bに固着させる純銅線12aの本数や長さに応じて、ヒートシンク12の表面積を自由に変えることができるものであり、放熱効果の調整が容易に可能である。

【0025】また、純銅線12aは柔軟性を有するものであるため、セラミックパッケージ装置の実装スペースに応じて容易に変形できる。たとえば、実装スペースに高さ方向の余裕がある場合には放射の角度を狭め、また、横方向に余裕がある場合には逆に放射の角度を拡げるなど、実装性をも向上し得る。

【0026】なお、あらかじめ所定の長さに切り揃えら ックパッケージ装置の実装スペースに応じて容易に変形れた複数本の純銅線12aの一端を半田12bにより固 50 できる。たとえば、実装スペースに余裕がない場合には

着させた後、他端を放射状に拡げることによっても同様 に形成できる。

【0027】図2は、第2の実施例にかかるセラミックパッケージ装置の概略構成を示すものである。なお、同図(a)はセラミックパッケージ装置の概略構成を示す外観斜視図であり、同図(b)は同じく断面図である。【0028】すなわち、このセラミックパッケージ装置は、たとえばPGAのパッケージを形成するセラミックケース11の表面に、放熱体としてのヒートシンク22が設けられた構成とされている。

【0029】PGAは、たとえば上記セラミックケース 11内に半導体チップ13を収納してなり、その裏面よ り、多数のリード端子14が並んで突き出した構成とさ れている。

【0030】PGAの、各リード端子14は、半導体チップ13上の電極パッド(図示していない)のそれぞれと、ボンディングワイヤ15を介して電気的に接続されている。

【0031】ヒートシンク22は、たとえば細い純銅線(金属細線)22aがくちゃくちゃに丸められて、所謂、金属タワシ状に形成されてなり、固着剤としての半田22bを介して、上記PGAのセラミックケース11の表面に固着されるようになっている。

【0032】とこで、ヒートシンク22の形成方法について説明する。たとえば、細くて長い純銅線22aが不規則的にまとめられて、金属タワシ状に形成される。この場合、長い純銅線22aを、細い穴を通して所定形状のケース(図示していない)内に押し込んでくちゃくちゃに丸めたり、純銅製の円柱体を細長く削るなどすることによって形成できる。

【0033】 こうして、所定長の純銅線22aによって 形成された純銅線22aのかたまりが、半田22bによ り固着される。このようにして形成されるヒートシンク 22は、純銅線22aの長さを延ばし、できるだけ密に まとめることにより、その表面積をかせぐことが可能と かる

[0034] すなわち、このヒートシンク22の場合、非常に長い純銅線22aを用いて小さく形成することにより、同一体積あたりの表面積を容易に増加することができる。これにより、従来の下駄歯構造のヒートシンクなどに比して、簡単に、かつ格段に、その表面積を増大させることが可能となる。したがって、熱抵抗を低下できるとともに、より高い放熱効果が得られるようになるものである。

【0035】しかも、純銅線22aの長さに応じて、ヒートシンク22の表面積を自由に変えることができるものであり、放熱効果の調整が容易に可能である。また、純銅線22aは柔軟性を有するものであるため、セラミックパッケージ装置の実装スペースに応じて容易に変形できる。たとえば、実装スペースに余裕がない場合には

押しつぶして小さくし、逆に、余裕がある場合には拡げ るなど、実装性をも向上し得る。

【0036】なお、一端があらかじめ半田22bに固着 された複数本の純銅線22aをカールしてコイル状に巻 きつけ、それらを1つにまとめることによっても同様に 形成できる。

【0037】上記したように、同一体積あたりの表面積 を増加できるようにしている。すなわち、細い純銅線を 密にして設けることで、ヒートシンクを形成するように している。これにより、ヒートシンクの表面積を簡単に 10 増加できるようになるため、その分だけ放熱効果または コンパクト性を向上することが可能となる。したがっ て、大型化を招くことなく、十分な放熱効果が期待でき るようになるものである。

【0038】また、柔軟性をもって形成できるようにな るため、容易な変形が可能であり、実装スペースの変化 にも柔軟に対応することが可能となるものである。な お、上記実施例においては、PGAを例に説明したが、 これに限らず、たとえば他のセラミックパッケージ装置 用できる。

[0039]また、金属細線としては純銅線に限らず、\*

\* 金などの放熱性の優れた細線を用いることもできる。さ らに、半田の他、導熱性に優れた各種の固着剤を用いる ことが可能である。その他、この発明の要旨を変えない 範囲において、種々変形実施可能なことは勿論である。 [0040]

【発明の効果】以上、詳述したようにこの発明によれ は、十分な放熱効果が期待でき、実装スペースの変化に も柔軟に対応することが可能な半導体装置およびその製 造方法を提供できる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の第1の実施例にかかるセラミックバ ッケージ装置を概略的に示す構成図。

【図2】この発明の第2の実施例にかかるセラミックバ ッケージ装置を概略的に示す構成図。

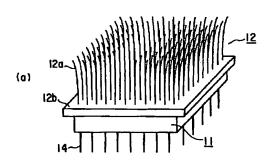
【図3】従来技術とその問題点を説明するために示すセ ラミックパッケージ装置の概略構成図。

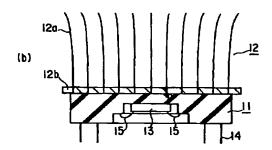
#### 【符号の説明】

(a)

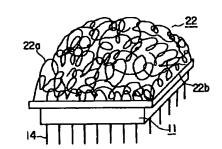
11…セラミックケース、12,22…ヒートシンク、 12a, 22a…純銅線、12b, 22b…半田、13 や発熱が問題となる各種のパッケージ装置にも同様に適 20 …半導体チップ、14…リード端子、15…ボンディン グワイヤ。

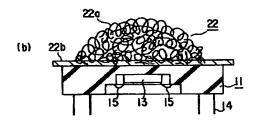
【図1】





【図2】





[図3]

